

### 关键指标

频率: 18~24GHz  
增益: 20.5dB  
噪声系数: 1.6dB  
1dB 压缩点输出功率: 2.5dBm  
工作电压: +5V  
工作电流: 12mA  
芯片尺寸: 1.6mm×1mm×0.1mm

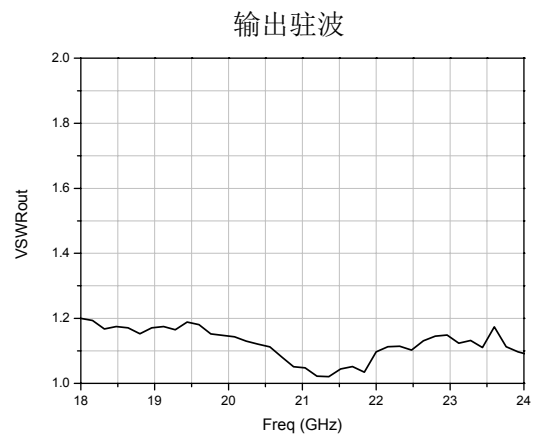
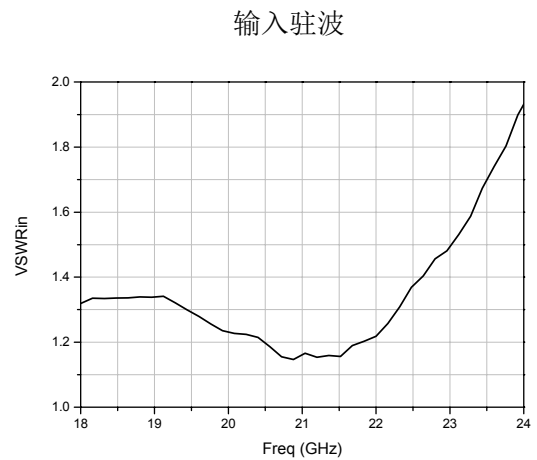
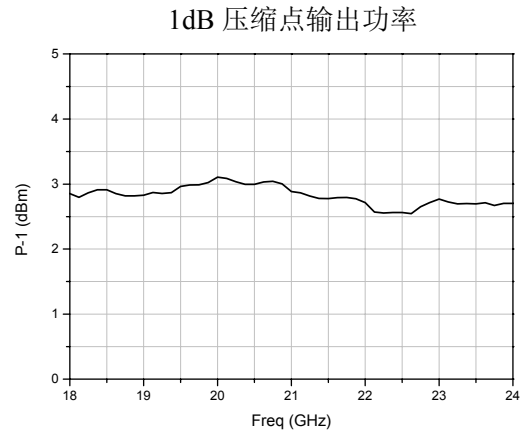
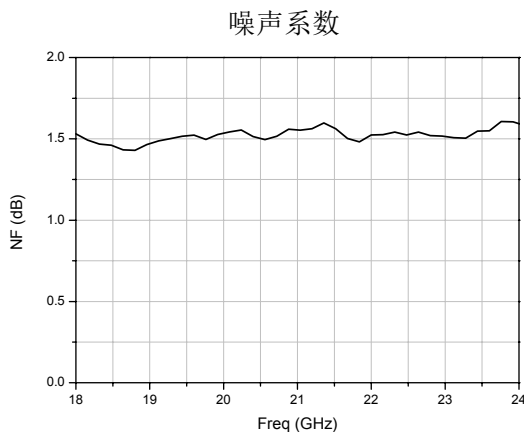
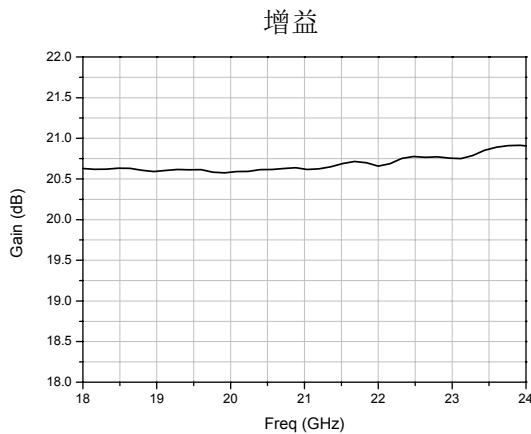
### 产品简介

HG117FB 是一款 18~24GHz 低噪声放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 增益为 20.5dB, 噪声系数小于 1.8dB, 1dB 压缩点输出功率为 2.5dBm。

### 电性能 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}, V_{dd}=+5\text{V}$ )

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	18~24		
增益(dB)	—	20.5	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输入驻波	—	1.6	—
输出驻波	—	1.3	—
噪声系数(dB)	—	1.6	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	2.5	—

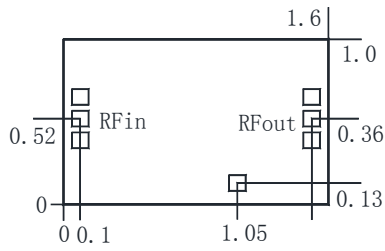
### 典型测试曲线



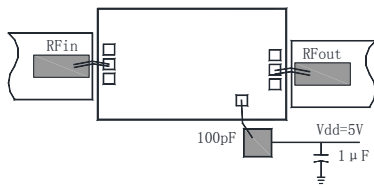
### 绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+15dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片输入输出微波端均有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。